

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-237468  
 (43)Date of publication of application : 23.08.2002

(51)Int.Cl. H01L 21/28  
 H01L 21/02  
 H01L 21/3063  
 H01L 21/316

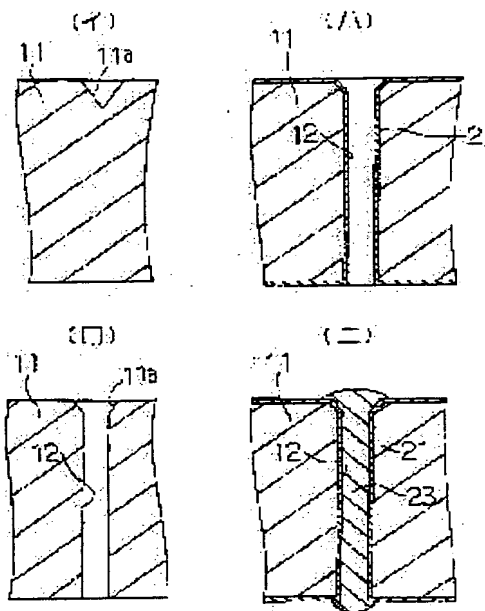
(21)Application number : 2001-034528 (71)Applicant : FUJIKURA LTD  
 (22)Date of filing : 09.02.2001 (72)Inventor : TAKIZAWA ISAO  
 SATOU AKINOBU  
 SUEMASU TATSUO  
 ITOI KAZUHISA

(54) METHOD OF FORMING ELECTRODE PASSED THROUGH SUBSTRATE, AND SUBSTRATE HAVING THROUGH ELECTRODE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a through electrode passed through a silicon substrate and having a high aspect ratio.

SOLUTION: A through hole 12 having a high aspect ratio is formed by a photo-excited electrolytic polishing process in a silicon substrate 11. The inner wall of the through hole 12 is subjected to oxidation to form an oxide film 21 as an insulating layer. Then a metal 23 is filled into the through hole 12 by a melted metal refilling process to form a through electrode (23). The through electrode 12 having a high aspect ratio can be easily formed in the substrate 11, and thus there can be easily achieved a semiconductor package having, e.g. stacked silicon IC chips.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 13.07.2001  
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]  
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
 [Date of final disposal for application]  
 [Patent number] 3599325  
 [Date of registration] 24.09.2004  
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]  
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]  
 [Date of extinction of right]

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## \* NOTICES \*

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

CLAIMS

---

## [Claim(s)]

[Claim 1] The penetration electrode formation approach of the substrate which is the penetration electrode formation approach which forms a penetration electrode in substrates, such as a silicon substrate, oxidizes the wall of this through tube, forms [ the through tube of a high aspect ratio is formed in a substrate, and ] the oxide film as an insulating layer with optical-pumping electrolytic polishing, and is characterized by being filled up with a metal by the molten-metal backfilling method subsequently to said through tube.

[Claim 2] The penetration electrode formation approach of the substrate according to claim 1 characterized by having the process which faces forming the oxide film as an insulating layer in a through tube wall, once removes the oxide film formed in the through tube wall, oxidizes a through tube wall again after that, and forms an oxide film once [ at least ].

[Claim 3] The penetration electrode formation approach of the substrate according to claim 1 characterized by facing forming the oxide film as an insulating layer in a through tube wall, carrying out high-concentration impurity diffusion to a through tube wall, and forming an impurity diffused layer in the outside of an oxide film.

[Claim 4] It is the substrate which it is substrates, such as silicon which has a penetration electrode, and said penetration electrode is formed by optical-pumping electrolytic polishing, consists of a through tube which has an oxide film in a wall, and a metal with which said through tube was filled up, and has the penetration electrode characterized by forming at least one place of said penetration electrode in said substrate.

---

[Translation done.]

## \* NOTICES \*

JPO and NCIPJ are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## DETAILED DESCRIPTION

## [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field belonging to invention] The penetration electrode formation approach that this invention forms a penetration electrode in substrates, such as a silicon substrate, Like [ in the case of forming a penetration electrode in the silicon substrate at the time of carrying out the laminating of the silicon IC chip, and carrying out high density assembly, concerning the device using the substrate which has at least one penetration electrode formed by the approach concerned, and the substrate concerned, ] When you need the penetration electrode of a high aspect ratio, it relates with various devices, such as the penetration electrode formation approach of a suitably applicable substrate, and an electron device which carried out substrates, such as silicon which has a penetration electrode, and the substrate concerned at the base, an optical device.

[0002]

[Description of the Prior Art] For example, as an approach of forming the penetration electrode which penetrates a front flesh side to a silicon substrate, after performing anisotropic etching, an oxide film is formed and the method of taking a flow with solder is proposed. In this case, as shown in drawing 11, the through tube 2 formed in the silicon substrate 1 by anisotropic etching becomes what has a big area of opening to substrate thickness. 3 shows an oxide film and 4 shows solder. moreover, ICP-RIE (Inductively Coupled Plasma-Reactive Ion Etching) which forms a penetration electrode in a silicon substrate — the approach of forming a through tube using law, and carrying out metal plating of the through tube wall, and forming a penetration electrode is also proposed.

[0003] On the other hand, optical-pumping electrolytic polishing (J. Electrochem.Soc., Vol.137, No.2, 653 to pp659 reference) is known as a technique which forms the through tube of a high aspect ratio (hole opening aspect product to the depth) in a silicon substrate. The detail of this optical-pumping electrolytic polishing is mentioned later.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the approach of of the above-mentioned conventional anisotropic etching and solder, since an etching configuration has constraint and the area of opening of the through tube to the thickness of a silicon substrate 1 becomes large, the penetration electrode of a high aspect ratio cannot be formed and it is not fit for formation of the penetration electrode to the silicon substrate in the case of performing high density assembly of a silicon IC chip.

[0005] moreover, since it is [ in a through tube ] deep and the until penetration of reactant gas or the plating liquid cannot be carried out by the approach of ICP-RIE and metal plating, it is difficult too to form the penetration electrode of a high aspect ratio.

[0006] Moreover, in the configuration of the through tube formed with optical-pumping electrolytic polishing, since a side branch etc. arises, a flat wall surface is not obtained.

[0007] This invention was made in view of the above-mentioned situation, and it is possible to form the penetration electrode of a high aspect ratio, and it aims at offering the substrate which has the penetration electrode formation approach and penetration electrode of a substrate which can make flat the wall of a through tube with which a penetration electrode is formed.

[0008]

[Means for Solving the Problem] This invention which solves the above-mentioned technical problem is the penetration electrode formation approach which forms a penetration electrode in substrates, such as a silicon substrate, it forms the through tube of a high aspect ratio in a substrate, oxidizes the wall of this through tube, forms the oxide film as an insulating layer, and, subsequently to said through tube, is characterized by being filled up with a metal by the molten-metal backfilling method.

[0009] Claim 2 is characterized by facing forming the oxide film as an insulating layer in a through tube wall, once removing the oxide film formed in the through tube wall, oxidizing a through tube wall again after that, and forming an oxide film in the penetration electrode formation approach of the substrate of claim 1.

[0010] Claim 3 is characterized by facing forming the oxide film as an insulating layer in a through tube wall, carrying out high-concentration impurity diffusion to a through tube wall, and forming an impurity diffused layer in the outside of an oxide film in the penetration electrode formation approach of the substrate of claim 1.

[0011] Claims 4 are substrates, such as silicon which has a penetration electrode, said penetration electrode is formed by optical-pumping electrolytic polishing, and consists of a through tube which has an oxide film in a wall, and a metal with which said through tube was filled up, and said penetration electrode is characterized by the substrate which has the penetration electrode currently formed at least one place in said substrate.

[0012]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the gestalt of operation of this invention is explained with reference to drawing 1 - drawing 10. This operation gestalt assumes the case where a penetration electrode is formed in the silicon substrate at the time of carrying out the laminating for example, of the silicon IC chip, and carrying out high density assembly.

\*\* First, as shown in the drawing 1 (\*\*), form V type hollow (this example is square drill-like hollow) 11a by the anisotropic etching which used etching reagents, such as KOH, for the silicon substrate 11.

[0013] \*\* Subsequently to the location of V type hollow 11a of said silicon substrate 11, form a through tube 12 like drawing 1 (b) with optical-pumping electrolytic polishing. It explains with reference to the optical-pumping electrolytic-polishing equipment 10 and drawing 3 which showed the principle of formation of the through tube 12 by optical-pumping electrolytic polishing to drawing 2. The silicon substrate 11 of n mold which formed V type hollow 11a in surface 11b by KOH beforehand as mentioned above Being immersed in the electrolytic solution 13 which consists of an HF solution in a cell 18, and irradiating light (14 showing the light source) through the infrared filter 17 at rear-face 11c corresponding to said V type hollow 11a of this silicon substrate 11 If a current (16 shows DC power supply) is passed between said silicon substrates 11 and cathode electrodes 15 which were made into the anode plate, said V type hollow location of a silicon substrate 11 will be etched alternatively, and a through tube 12 will be formed in this V type hollow location. If optical 14a is irradiated at the rear face of the silicon substrate 2 of n mold as it is shown in drawing 3, when the principle etched alternatively is explained When a minority carrier (electron hole) is generated with the rear face of a silicon substrate 2 by excitation by the optical exposure and the minority carrier concentrates at the tip of V type hollow 11a of the shape of a square drill by the side of a front face Only the tip of V type hollow 11a is etched electrochemically, the etching advances, and a through tube is formed. As a concrete example of formation of the through tube 12 by this optical-pumping electrolytic polishing, for example in 50 degrees C and 2.5wt% HF etching reagent, it grinds in illuminance 6 mW/cm [ of light ], 0.1mA [ of force current ], and impression time amount 24 hours, for example, a through tube with a diameter [ of

15 micrometers ] and a depth of 400 micrometers is formed.

[0014] Subsequently, as it oxidizes and the wall of said through tube 12 is shown in drawing 1 (Ha), the oxide film 21 as an insulating layer is formed. Formation of an oxide film 21 can be formed for example, by the oxidizing [ thermally ] method. As a concrete example of thermal oxidation, it puts to the wet ambient atmosphere which poured the steam of 1100 degrees C and 2000 cc/min. for 3 hours, for example, and an oxide film 21 is formed.

[0015] In addition, since a side branch etc. produces the wall of a through tube established with optical-pumping electrolytic polishing and a flat internal surface is not obtained when forming an oxide film 21 as an insulating layer, it is desirable to remove the once formed oxide film 21, to oxidize again, and to form an oxide film. Thereby, flattening of the internal surface of a through tube 12 can be carried out, and a good penetration electrode can be formed. In addition, oxide film removal can be performed by etching the oxide film in a through tube 12 alternatively by BOE (buffered fluoric acid) etc. Moreover, if the process of said oxide-film removal and oxide-film reconstitution is repeated two or more times depending on the case, flattening of the internal surface of a through tube 12 can be carried out further.

[0016] Moreover, in case an oxide film is formed, high-concentration impurity diffusion can be performed and the layer (impurity diffusion tub) formed of it can be used as a shielding layer. 22 shows the impurity diffused layer formed in drawing 4 by impurity diffusion. A noise can be controlled by formation of a shielding layer. It is good to diffuse the matter which forms p type layers, such as boron, as an impurity to diffuse, for example in the case of n mold silicon substrate. Moreover, impurity diffusion can be performed with a thermal diffusion method. According to this thermal diffusion method, since formation of the insulating layer on an impurity diffused layer 22 (oxide film 21) can also be performed to coincidence, it is efficient. If a drive-in is performed as a concrete example of the impurity diffusion by thermal diffusion for 1,100 degrees C, a wet oxidizing atmosphere, and 3 hours after carrying out deposition of the boron glass by nitrogen-gas-atmosphere method for 950 degrees C and 1 hour using the source of impure of solid phase or a gaseous phase when diffusing boron, for example in n mold silicon substrate, an about 2-micrometer high concentration P++ layer (impurity diffused layer 22) will be formed, for example.

[0017] Subsequently, by the molten-metal backfilling method, as shown in drawing 1 (d), it is filled up with a metal 23 in a through tube 12. A molten-metal backfilling method is the approach of filling up with a metal detailed space, such as micropore formed in the silicon substrate (work piece) used as a processed object. First, decompress the ambient pressure of the work piece which it is going to fill up with a metal, and, subsequently the reduced pressure condition has been maintained. It is the approach characterized by inserting said work piece in molten metal, pressurizing the ambient pressure of said molten metal subsequently, filling up said space with molten metal according to the ambient pressure difference before and behind metal insertion, pulling up a work piece from a molten-metal tub, and subsequently cooling it. Here, although it is good for the eutectic solder of an indium (In), tin (Sn), or golden-tin etc. to have the comparatively low melting point, and to use a metal with low vapor pressure as a metal with which it is filled up, it is not limited to especially them. It is immersed in 300-degree C melting tin by using as a work piece the silicon substrate 11 which used molten-metal restoration equipment 30 like drawing 5, for example, for example, opened the through tube 12 in the reduced pressure ambient atmosphere of 10-3Pa (pascal) extent as a concrete example of this molten-metal backfilling, for example, you make it filled up with tin in the through tube 12 of the high aspect ratio in returning an ambient atmosphere to the bottom of atmospheric pressure after that.

[0018] Said molten-metal restoration equipment 30 had the vacuum chamber 31 which has arranged the molten-metal tub 43 with heater 44, and the vacuum chamber 37 for buffers which is open for free passage by the opening 36 which can be opened and closed by the shutter 35 to this, and the arm 47 for work-piece immobilization which grasps a silicon substrate 11 is attached in the lid 50. It connects with vacuum pump equipment 34 through the siphon 33 or the siphon 38 for vacuum rough length, and both the chambers 31 and 37 are connected to the nitrogen gas cylinder of illustration abbreviation through the nitrogen installation tubing 39 and 40.

[0019] Explanation of the work habits which fill up a metal with above metal restoration equipment 30 into the through tube 12 of a silicon substrate 11. vacuum-rough-lengthens the vacuum chamber 37 interior for buffers with vacuum pump equipment 34, where the silicon substrate 11 which closed the lid 50 and was grasped with the arm 47 for work-piece immobilization is located in the vacuum chamber 37 for buffers. Subsequently, a shutter 35 is opened (in addition, the vacuum chamber 31 is decompressed previously). Subsequently, with vacuum-pump equipment 34, vacuum suction of the interior of the vacuum chamber 11 and the vacuum chamber 17 for buffers is carried out, and it decompresses to about 10-2 to 10-3Pa of vacuum pressure. Subsequently, it heats at a heater 44, melting of the metal in the molten-metal tub 43 is carried out, and a silicon substrate 11 is inserted into molten metal 23. After a silicon substrate 11 reaches the same temperature as molten metal 23, the nitrogen from a nitrogen gas cylinder is introduced in the vacuum chamber 11 and the vacuum chamber 17 for buffers, and the interior is pressurized to two to 5x105Pa (2-5 kgf/cm2) extent. This pressurization is filled up with molten metal 23 in the through tube 12 which is a high aspect ratio. Then, a silicon substrate 11 is pulled up from the molten-metal tub 43, it takes out besides the vacuum chamber 31, and air cooling is carried out at a room temperature. Thereby, the metal restoration activity to the through tube 12 of a silicon substrate 11 is completed.

[0020] In addition, as an approach of forming an insulating layer (oxide film) in the internal surface of a through tube 12, not only the above-mentioned oxidizing [ thermally ] method but forming under a low temperature service by the liquid phase of for example, the coating liquid for SiO2 system coat formation etc. is considered. Since this approach does not have the effect by heat on them when the circuit etc. is already formed on the silicon substrate 11, it becomes advantageous.

[0021] This invention applies and is suitable for the laminating high density assembly (three-dimension mounting) of a silicon IC chip. Drawing 7 is the cross-sectional view showing the layered product of a silicon IC chip (silicon substrate). 71 in drawing is the silicon IC chip with which two penetration electrodes 72 were formed by optical-pumping electrolytic polishing, and the three-sheet laminating in all of this silicon IC chip 71 is carried out in the up-and-down location on the base substrate 73. When the silicon IC chip 71 has the same circuit pattern cut down from the same wafer and looks at it from a wafer front face, the penetration electrode 72 and a circuit pattern (not shown) are formed in the same location in each chip, and these penetration electrodes 72 double a vertical edge, and are connected. The penetration electrode upper limit on the other party chip is connected with the solder bump 74 prepared in the \*\*\*\* beehive and the electrode lower limit, and alignment connection of the penetration electrode 72 of these chips is made with the penetration electrode 72 formed in the base substrate 73 made from silicon. Consequently, the common electrode which penetrates a base substrate and a silicon IC chip is formed, and the solder ball 70 of the lower limit of this common electrode is connected with the wiring circuit of the base substrate which is not illustrated. However, when carrying out a design which does not dare arrange the vertical location of a penetration electrode, it is also possible to connect the solder bump of one chip lower part with the circuit pattern (electrode layer formed on the penetration electrode and the chip of another side through which it flows) of the chip upper part of another side. As mentioned above, it is possible to make the three-dimension IC device whose packaging density was accumulated on two or more layers and improved by [ which position how many sheets of that IC chip in an arbitration location, and makes superposition connection ] having formed the penetration electrode of a high aspect ratio. In addition, the number of penetration electrodes is not limited to two, but this [ its ] is the same also in other examples.

[0022] Drawing 8 is other examples of this invention, and shows chip size mounting of IC chip using INTAPOZA. On those with INTAPOZA (silicon substrate) made from silicon which have two penetration electrodes 82 in which 81 in drawing was formed by optical-pumping electrolytic polishing, and this INTAPOZA, the IC chip 83 by which the face down was carried out is carried. The electrode 84 of IC chip front face is connected to the penetration electrode 82 through the conductive layer 85 on the front face of INTAPOZA, and the solder ball 86 formed in penetration electrode 82 lower limit is connected with the circuit pattern on a mother board (base substrate) 80 on this INTAPOZA inferior surface of tongue. Although connection with a mother board had much constraint and there was a limitation also in a wiring consistency by chip mounting using INTAPOZA conventionally, in this example, by forming two or more penetration electrodes of a high aspect ratio, constraint of a circuit pattern design of INTAPOZA decreases and mounting structure (or package structure) can be simplified. Furthermore, since silicon is used as a material of INTAPOZA, in case the adjustment of IC chip and a coefficient of thermal expansion becomes good and it mounts to a mother board as compared with the thing made from other ceramics, there is little thermal stress distortion which a chip receives, and since the heat transfer effectiveness of silicon is comparatively excellent, the advantage of being easy to miss the generating heat of a chip is acquired. Furthermore, since the silicon high precision

processing technology which has generally spread can be used, the advantage that the elaboration of a surface circuit pattern is possible is also acquired.

[0023] Drawing 9 (A) is other examples of this invention, and shows the image sensors which have a penetration electrode. 91 are the photoelectric element area in the image-sensors chip 90 among drawing, and 92 is the penetration electrode of a high aspect ratio formed in the silicon substrate 93 by optical-pumping electrolytic polishing. This penetration electrode 92 is formed in a chip edge on the outside of the active region (photoelectric element area in which the photoelectric transducer was formed) 91 of image sensors, and the upper limit is connected to the active region 91 through the electrode layer on the front face of a chip. Moreover, the lower limit is connected with the circuit pattern on the front face of a mother board which is not illustrated through solder ball 94 grade.

[0024] Drawing 9 (B) shows the image sensors of a wire connection type. In this Fig., image sensors formed in the same field as the component area of a chip the wire bond pad 95 with a comparatively big area which flows in this component area, and have connected it with the external leadframe etc. by the bonding wire 96. moreover, a gold streak (wire) — in order to mitigate the effect of the heat generated at the time of connection, the area of the image area which needs to carry out extent isolation and which is occupied on a chip front face from the above reason which a wire bond pad and image area have has constraint.

[0025] On the other hand, in this invention, since it connects with the photoelectric element area 91 through the conductive layer 97 and the penetration electrode upper limit of a high aspect ratio is connected with the exterior by the solder ball 94 of a penetration electrode lower limit, the wirebonding pad to the same field as image area becomes unnecessary. Therefore, since component area occupied to the chip area of image sensors can be enlarged, the component area of a large area is [ image sensors ] securable in a miniaturization or the chip of the limited magnitude. Moreover, since wirebonding is unnecessary, the surface mount to a base substrate becomes easy, and can measure reduction of a manufacturing cost in small [ of an image chip mounting substrate ], thin-shape-izing, and a list.

[0026] Drawing 10 is other examples of this invention, and shows the cross-sectional view of an optical circuit element (optical transmitter) in which the penetration electrode of a high aspect ratio was formed. Four penetration electrode 101A in which 100 in drawing was formed by optical-pumping electrolytic polishing. The platform made from silicon (silicon substrate) which has 101B and 101C (other one place is not shown) and by which precision processing was carried out, and 101 The projected part of the V groove which carries out positioning immobilization of the optical fiber 106, and the cross-section trapezoidal shape to which, as for 102, the top face to which one electrode surface of the surface mounting mold (laser diode) LD 103 is connected makes conductive layer 102A, 104 is a crevice of reverse trapezoidal shape where the concave pars basilaris ossis occipitalis connected to the single-sided electrode surface of PD105 for monitors (photo diode) makes conductive layer 104A. Conductive layer 102A, conductive layer 104A, and the flowing penetration electrodes 101A and 101B are formed in this projected part 102 and the lower part of this crevice 104, and the lower limit section of these penetration electrodes 101A and 101B is connected to them with the external circuit which does not form and illustrate a solder bump (pad). On the other hand, other two penetration electrode 101C (one place is not shown) is connected to two electrode pads 110 (one place is not shown) on platform surface 100A, and two bonding wires (gold streak) 109A and 109B derived from these electrode pad are connected to other single-sided electrode surfaces of LD103 and PD105. furthermore — concrete — a gold streak — direct bonding of the 109A is carried out to the single-sided electrode on LD103 — having — a gold streak — direct continuation of the 109B is connected with the extension section of conductive layer 104A plated on the platform rather than it is carried out to a component electrode. In the lower part of a platform 100, the surface mount of the lower limit of these penetration electrode is carried out to a mounting substrate through the solder ball 111 etc.

[0027] Next, the optical axis is set so that it may be in agreement with the axial center 107 of an optical fiber 106, the outgoing radiation light of LD103 carries out incidence of the direction of a list of these light device to an optical fiber, and PD105 carries out the monitor of the LD output. According to this example, since each conductive layers 102A and 104A of the light corpuscle child lower part have flowed with the external circuit through the penetration electrodes 101A and 101B, formation of the circuit pattern on a platform front face is simplified. Moreover, as compared with connecting an external leadframe with a light corpuscle child from the electrode pad 110 in a platform, since it is only between light corpuscle children, wire length becomes short and it becomes easy to connect wire (gold streak) bonding. therefore, the optical whole device not only being miniaturized but a connection man day — \*\*\*\*\* — since things are made, there is an advantage to which product cost can be reduced. In addition, the configuration of the above-mentioned platform can be changed and a configuration which receives the external incident light from an optical fiber by PD for light-receiving, then an optical receiver can be constituted. Moreover, an optical fiber is made into two (it is v slot two), and an optical transceiver can be constituted, if a platform is processed and an optical transmitter and an optical receiver are fixed on the same platform.

[0028] As explained above, this invention can form the penetration electrode of a high aspect ratio in various components, and since use of general-purpose silicon high precision processing technology is possible, it can measure various components, the elaboration of a device, a miniaturization, and improvement in packaging density. Moreover, it is complicated, and since the process of the wire bond used as cost quantity etc. can be skipped, it also becomes possible to reduce product cost. In addition, although the case of this invention where a penetration electrode is formed in a silicon substrate is main, forming a penetration electrode in the substrate by materials other than silicon is also considered.

[0029]

[Effect of the Invention] Since according to this invention the through tube of a high aspect ratio is formed in a substrate, for example with optical-pumping electrolytic polishing, the wall of this through tube is oxidized, the oxide film as an insulating layer is formed, it is filled up with a metal by the molten-metal backfilling method and a penetration electrode is formed subsequently to said through tube, the penetration electrode of a high aspect ratio can be obtained easily. It becomes easy for this to realize the semiconductor package and the optical device of the high density assembly which carried out the laminating for example, of the silicon IC chip etc.

[0030] If it reoxidates and an oxide film is formed once removing the oxide film formed in the through tube wall like claim 2, flattening of the through tube wall can be carried out, and a good penetration electrode can be formed.

[0031] If high-concentration impurity diffusion is carried out to a through tube wall and an impurity diffused layer is formed in the outside of an oxide film like claim 3, this impurity diffused layer can be used as a shielding layer, and it is effective in control of a noise.

[Translation done.]

## \* NOTICES \*

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## DESCRIPTION OF DRAWINGS

## [Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the mimetic diagram which divides the penetration electrode formation approach of the substrate of 1 operation gestalt of this invention into a process, and explains it, and the phase where (\*\*) formed the V type hollow in the silicon substrate, the phase in which (\*\*) opened the through tube with optical-pumping electrolytic polishing, the phase where (Ha) formed the oxide film in the through tube wall, and the phase which (d) filled up the through tube with the metal and formed the penetration electrode are shown.

[Drawing 2] In the penetration electrode formation approach of this invention operation gestalt, it is the mimetic diagram of the optical-pumping electrolytic-polishing equipment used for formation of a through tube.

[Drawing 3] It is drawing explaining the principle by which alternative etching is performed to a V type hollow with the above-mentioned optical-pumping electrolytic polishing.

[Drawing 4] It is the mimetic diagram showing the condition of having performed impurity diffusion and having formed the shielding layer (impurity diffusion) on the occasion of formation of the oxide film of drawing 1 (Ha).

[Drawing 5] a part of important section of the metal restoration equipment used for the metal restoration to a through tube in the penetration electrode formation approach of this invention operation gestalt — it is a notching front view.

[Drawing 6] The example which actually formed the penetration electrode in the silicon substrate by the above-mentioned penetration electrode formation approach is shown, and it is the sketch of the microphotography of the cross section of the penetration electrode section of a silicon substrate.

[Drawing 7] It is the cross-sectional view of the layered product of a silicon IC chip (silicon substrate).

[Drawing 8] It is drawing in which showing other examples of this invention and showing chip size mounting of IC chip using INTAPOZA.

[Drawing 9] The sectional view of the image sensors which (A) shows the example of further others of this invention, and have a penetration electrode, and (B) are the sectional views showing the image sensors of a wire connection type.

[Drawing 10] It is the cross-sectional view of an optical circuit element (optical transmitter) in which the example of further others of this invention is shown, and the penetration electrode of a high aspect ratio was formed.

[Drawing 11] It is the typical sectional view of a penetration electrode section when a penetration electrode forms in a silicon substrate by the approach of of the conventional anisotropic etching and solder.

## [Description of Notations]

10 Optical-Pumping Electrolytic-Polishing Equipment

11 Silicon Substrate

11a V type hollow

11b The front face of a silicon substrate

11c The rear face of a silicon substrate

12 Through Tube

13 Electrolytic Solution

14 Light Source

15 Cathode Electrode

21 Oxide Film

22 Impurity Diffused Layer (Shielding Layer)

23 Restoration Metal (the Same Sign Also Shows Molten Metal)

30 Metal Restoration Equipment

31 Vacuum Chamber

37 Vacuum Chamber for Buffers

34 Vacuum Aspirator

43 Molten-Metal Tub

44 Heater

70 Solder Ball

71 Silicon IC Chip

72 Penetration Electrode

73 Base Substrate

74 Solder Bump

80 Mother Board (Base Substrate)

81 INTAPOZA made from Silicon (Silicon Substrate)

82 Penetration Electrode

83 IC Chip

84 Electrode

85 Conductive Layer

86 Solder Ball

90 Image-Sensors Chip

91 Photoelectric Element Area (Active Region of Image Sensors)

92 Penetration Electrode

93 Silicon Substrate

94 Solder Ball

97 Conductive Layer

100 Platform made from Silicon (Silicon Substrate)

101A, 101B, 101C Penetration electrode

101 V Groove  
101A, 101B Penetration electrode  
101C Penetration electrode  
102 Projected Part  
102A Conductive layer  
103 Surface Mounting Mold LD (Laser Diode)  
104 Crevice of Reverse Trapezoidal Shape  
104A Conductive layer  
105 PD (Photo Diode)  
106 Optical Fiber  
107 Axial Center  
109A, 109B Bonding wire (gold streak)  
110 Electrode Pad  
111 Solder Ball

---

[Translation done.]



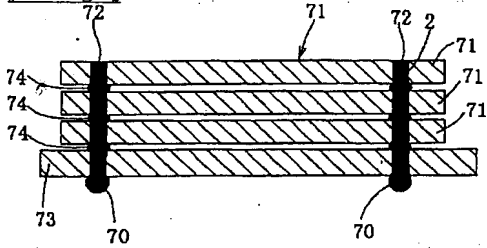
\* NOTICES \*

JPO and NCIPJ are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

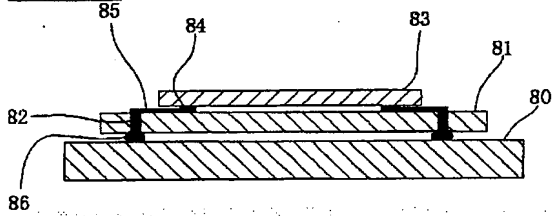
- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

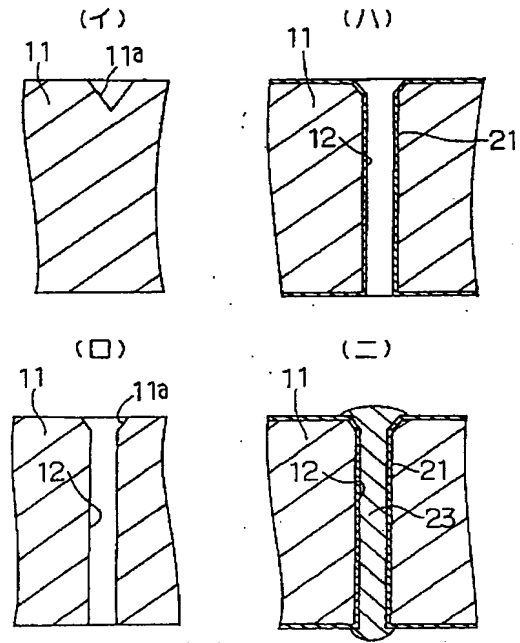
[Drawing 7]



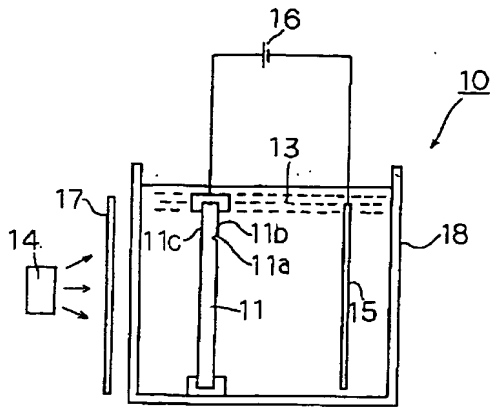
[Drawing 8]



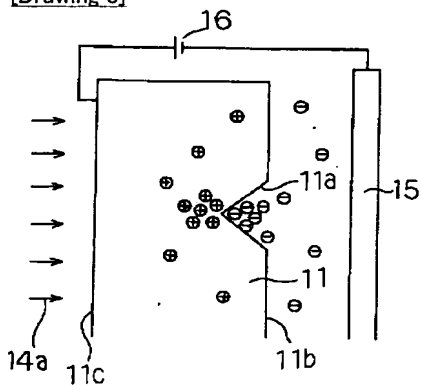
[Drawing 1]



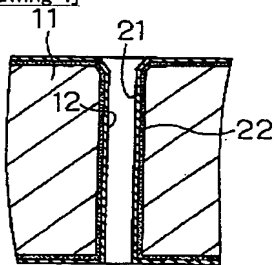
[Drawing 2]



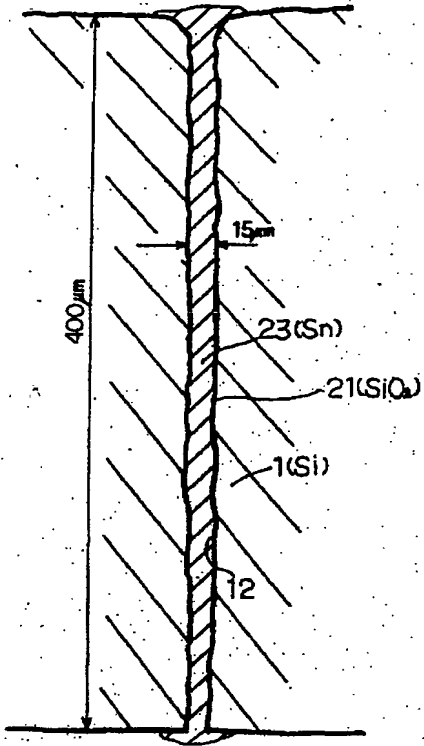
[Drawing 3]



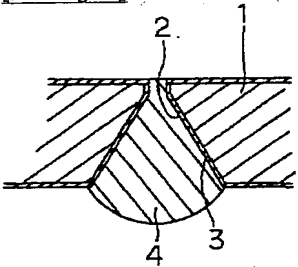
[Drawing 4]



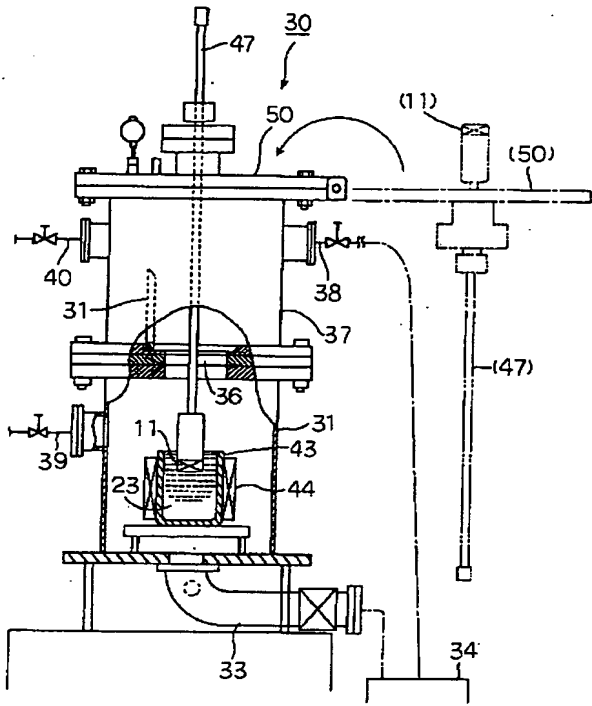
[Drawing 6]



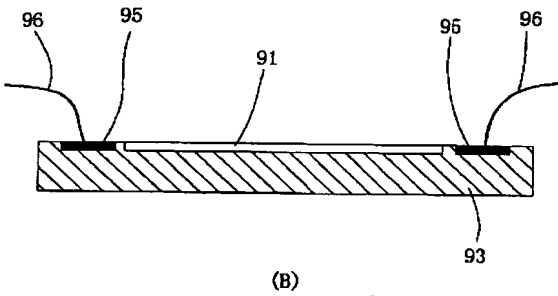
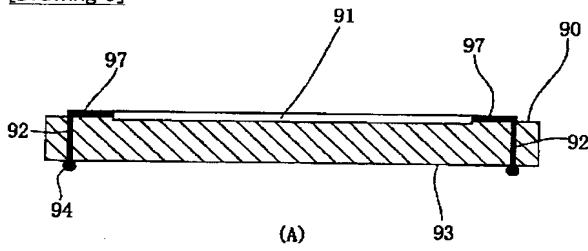
[Drawing 11]



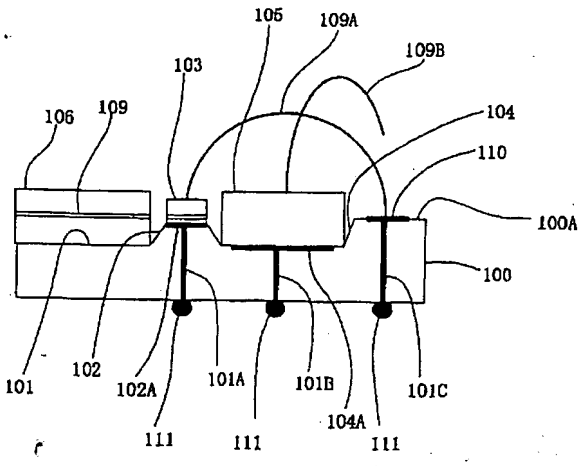
[Drawing 5]



[Drawing 9]



[Drawing 10]



[Translation done.]

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19) 日本国特許庁 ( J P )

(12) 公開特許公報 ( A )

(11) 特許出願公開番号  
特開2002-237468  
( P2002-237468A )

(43) 公開日 平成14年 8 月23日 (2002. 8. 23)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード* (参考)
H 0 1 L	21/28	21/28	E 4M104
	21/02	21/02	B 5F043
	21/3063	21/316	S 5F058
	21/316	21/306	L

審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2001-34528(P2001-34528)

(22) 出願日 平成13年 2 月 9 日 (2001. 2. 9)

(71) 出願人 000005186

株式会社フジクラ

東京都江東区木場 1 丁目 5 番 1 号

(72) 発明者 滝沢 功

東京都江東区木場 1-5-1 株式会社フジクラ内

(72) 発明者 佐藤 倬暢

東京都江東区木場 1-5-1 株式会社フジクラ内

(74) 代理人 100090549

弁理士 加川 征彦

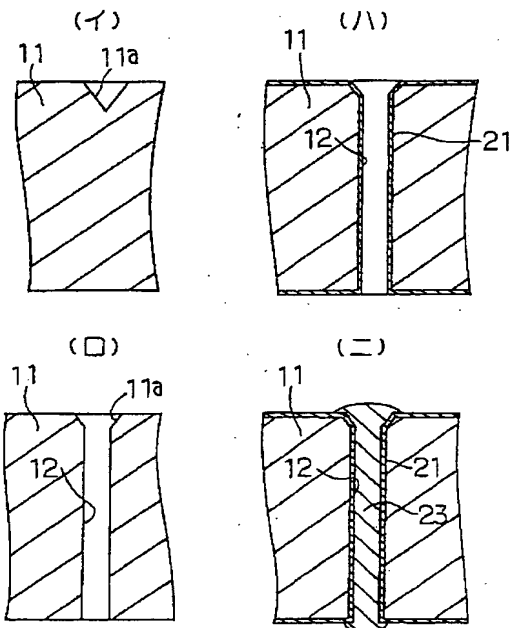
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 基板の貫通電極形成方法および貫通電極を有する基板

(57) 【要約】

【課題】 シリコン基板に高アスペクト比の貫通電極を形成する。

【解決手段】 光励起電解研磨法によりシリコン基板 11 に高アスペクト比の貫通孔 12 を形成する。この貫通孔 12 の内壁を酸化処理して絶縁層としての酸化膜 21 を形成する。次いで、貫通孔 12 に熔融金属埋め戻し法により金属 23 を充填して、貫通電極 (23) とする。シリコン基板 11 に高アスペクト比の貫通電極 12 を容易に形成でき、例えばシリコン IC チップを積層した高密度実装の半導体パッケージを実現すること等が容易になる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン基板等の基板に貫通電極を形成する貫通電極形成方法であって、  
光励起電解研磨法により、基板に高アスペクト比の貫通孔を形成し、この貫通孔の内壁を酸化処理して絶縁層としての酸化膜を形成し、次いで、前記貫通孔に熔融金属埋め戻し法により金属を充填することを特徴とする基板の貫通電極形成方法。

【請求項2】 貫通孔内壁に絶縁層としての酸化膜を形成するに際して、貫通孔内壁に形成した酸化膜を一旦除去し、その後再び貫通孔内壁を酸化処理して酸化膜を形成する工程を少なくとも一回有することを特徴とする請求項1記載の基板の貫通電極形成方法。

【請求項3】 貫通孔内壁に絶縁層としての酸化膜を形成するに際して、貫通孔内壁に高濃度の不純物拡散を行って、酸化膜の外側に不純物拡散層を形成することを特徴とする請求項1記載の基板の貫通電極形成方法。

【請求項4】 貫通電極を有するシリコン等の基板であって、

前記貫通電極は、光励起電解研磨法により形成され、内壁に酸化膜を有する貫通孔と、前記貫通孔に充填された金属よりなり、

前記貫通電極は前記基板内に少なくとも1カ所形成されていることを特徴とする貫通電極を有する基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明に属する技術分野】この発明は、シリコン基板等の基板に貫通電極を形成する貫通電極形成方法と、当該方法により形成された貫通電極を少なくとも1ヶ所有する基板、および当該基板を用いたデバイスに関し、例えば、シリコンICチップを積層して高密度実装する際のシリコン基板に貫通電極を形成する場合のように、高アスペクト比の貫通電極を必要とする場合に好適に適用できる基板の貫通電極形成方法と、貫通電極を有するシリコン等の基板、および当該基板をベースにした電子デバイスや光デバイスなどの各種デバイスに関する。

【0002】

【従来の技術】例えば、シリコン基板に表裏を貫通する貫通電極を形成する方法としては、異方性エッチングを行なった後、酸化膜を形成し、半田で導通を取る方法が提案されている。この場合、図11に示すように、異方性エッチングでシリコン基板1に形成した貫通孔2は、基板厚さに対する開口部の面積が大きくなるものとなる。3は酸化膜、4は半田を示す。また、シリコン基板に貫通電極を形成する、ICP-RIE (Inductively Coupled Plasma - Reactive Ion Etching) 法を用いて貫通孔を形成し、貫通孔内壁を金属メッキして貫通電極を形成する方法も提案される。

【0003】一方、シリコン基板に高アスペクト比(孔深さに対する開口部面積)の貫通孔を形成する技術とし

て、光励起電解研磨法(J. Electrochem. Soc., Vol.137, No.2, pp653-659参照)が知られている。この光励起電解研磨法の詳細は後述する。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記従来の異方性エッチング・半田の方法では、エッチング形状に制約があり、シリコン基板1の厚さに対する貫通孔の開口部の面積が大きくなるので、高アスペクト比の貫通電極を形成することはできず、シリコンICチップの高密度実装を行なおうとする場合における、シリコン基板への貫通電極の形成には向かない。

【0005】また、ICP-RIE・金属メッキの方法では、反応ガスやメッキ液が貫通孔内の奥深くまで進入できないので、やはり、高アスペクト比の貫通電極を形成することは困難である。

【0006】また、光励起電解研磨法により形成した貫通孔の形状では、サイドブランチ等が生じるため平坦な壁面が得られない。

【0007】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、高アスペクト比の貫通電極を形成することが可能であり、また、貫通電極が形成される貫通孔の内壁を平坦にできる基板の貫通電極形成方法および貫通電極を有する基板を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発明は、シリコン基板等の基板に貫通電極を形成する貫通電極形成方法であって、基板に高アスペクト比の貫通孔を形成し、この貫通孔の内壁を酸化処理して絶縁層としての酸化膜を形成し、次いで、前記貫通孔に熔融金属埋め戻し法により金属を充填することを特徴とする。

【0009】請求項2は、請求項1の基板の貫通電極形成方法において、貫通孔内壁に絶縁層としての酸化膜を形成するに際して、貫通孔内壁に形成した酸化膜を一旦除去し、その後再び貫通孔内壁を酸化処理して酸化膜を形成することを特徴とする。

【0010】請求項3は、請求項1の基板の貫通電極形成方法において、貫通孔内壁に絶縁層としての酸化膜を形成するに際して、貫通孔内壁に高濃度の不純物拡散を行って、酸化膜の外側に不純物拡散層を形成することを特徴とする。

【0011】請求項4は、貫通電極を有するシリコン等の基板であって、前記貫通電極は、光励起電解研磨法により形成され、内壁に酸化膜を有する貫通孔と、前記貫通孔に充填された金属よりなり、前記貫通電極は前記基板内に少なくとも1カ所形成されている貫通電極を有する基板を特徴とする。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図1～図10を参照して説明する。この実施形態は、例えば、シリコンICチップを積層して高密度実装する際の



シリコン基板に貫通電極を形成する場合を想定している。

①まず、図1(イ)に示すように、シリコン基板11に、KOH等のエッチング液を用いた異方性エッチングによりV形凹所(この例は四角錐状の凹所)11aを形成する。

【0013】②次いで、前記シリコン基板11のV形凹所11aの位置に、光励起電解研磨法により図1(ロ)のように貫通孔12を形成する。光励起電解研磨法による貫通孔12の形成の原理を図2に示した光励起電解研磨装置10および図3を参照して説明する。前記のように表面11bに予めKOHによりV形凹所11aを形成したn型のシリコン基板11を、電解槽18内のHF溶液からなる電解液13に浸漬し、このシリコン基板11の前記V形凹所11aに対応する裏面11cに赤外線フィルタ17を通して光(光源を14で示す)を照射しつつ、陽極とした前記シリコン基板11と陰極電極15との間に電流(直流電源を16で示す)を流すと、シリコン基板11の前記V形凹所位置が選択的にエッチングされ、このV形凹所位置に貫通孔12が形成される。選択的にエッチングされる原理を説明すると、図3に示すように、n型のシリコン基板2の裏面に光14aを照射すると、その光照射による励起でシリコン基板2の裏面で少数キャリア(正孔)が生成され、その少数キャリアが表面側の四角錐状のV形凹所11aの先端に集中することにより、V形凹所11aの先端のみが電気化学的にエッチングされ、そのエッチングが進行して貫通孔が形成される。この光励起電解研磨法による貫通孔12の形成の具体的な実施例としては、例えば、50℃、2.5wt%のHFエッチング液中にて、光の照度6mW/cm<sup>2</sup>、印加電流0.1mA、印加時間24時間で研磨を行い、例えば直径15μm、深さ400μmの貫通孔を形成する。

【0014】次いで、前記貫通孔12の内壁を酸化して、図1(ハ)に示すように、絶縁層としての酸化膜21を形成する。酸化膜21の形成は、例えば熱酸化法により形成することができる。熱酸化の具体的な実施例としては、例えば、1100℃、2000cc/min.のステージムを流したウェット雰囲気3に3時間曝して、酸化膜21を形成する。

【0015】なお、絶縁層として酸化膜21を形成する場合、光励起電解研磨法で設けた貫通孔の内壁はサイドブランチ等が生じて平坦な内壁面が得られないので、一旦形成した酸化膜21を除去し、再度酸化して酸化膜を形成することが望ましい。これにより、貫通孔12の内壁面を平坦化でき、良好な貫通電極を形成できる。なお、酸化膜除去は、BOE(バッファードフッ酸)等により貫通孔12内の酸化膜を選択的にエッチングすることで行うことができる。また、場合によっては、前記酸化膜除去と酸化膜再形成の工程を複数回繰り返すと、貫

通孔12の内壁面を一層平坦化することができる。

【0016】また、酸化膜を形成する際に、高濃度の不純物拡散を行い、それによって形成される層(不純物拡散層)をシールド層として用いることができる。図4に不純物拡散により形成した不純物拡散層を22で示す。シールド層の形成により、ノイズを抑制できる。拡散させる不純物としては、例えば、n型シリコン基板の場合、ボロン等のp型層を形成する物質を拡散させるとよい。また、不純物拡散は例えば熱拡散法により行なうことができる。この熱拡散法によれば、不純物拡散層22の上の絶縁層(酸化膜21)の形成も同時に行なうことができるので、能率的である。熱拡散による不純物拡散の具体的な実施例としては、例えばn型シリコン基板にボロンを拡散する場合、固相ないしは気相の不純源を用い、950℃、1時間、窒素雰囲気中でボロンガラスをデポジションした後、1、100℃、ウェット酸化雰囲気、3時間ドライブインを行うと、例えば、2μm程度の高濃度P++層(不純物拡散層22)が形成される。

【0017】次いで、熔融金属埋め戻し法により、図1(ニ)に示すように貫通孔12内に金属23を充填する。熔融金属埋め戻し法とは、被加工対象となるシリコン基板(ワーク)に形成された微細孔などの微細空間に金属を充填する方法であって、まず、金属を充填しようとするワークの雰囲気圧を減圧し、次いで減圧状態を保ったまま、前記ワークを熔融金属に挿入し、次いで前記熔融金属の雰囲気圧を加圧して、金属挿入前後における雰囲気圧差により前記空間に熔融金属を充填し、次いでワークを熔融金属槽から引き上げて冷やすことを特徴とする方法である。ここで、充填する金属としては、インジウム(In)、スズ(Sn)、あるいは金-錫の共晶半田など比較的融点が低く、蒸気圧の低い金属を用いるとよいが、特にそれらに限定されない。この熔融金属埋め戻しの具体的な実施例としては、例えば図5のような熔融金属充填装置30を使用して、例えば10<sup>-3</sup>Pa(バスカル)程度の減圧雰囲気中で、貫通孔12をあけたシリコン基板11をワークとして、例えば300℃の熔融せずに浸漬し、その後、大気圧下に雰囲気を戻すことで高アスペクト比の貫通孔12内に錫を充填させる。

【0018】前記熔融金属充填装置30は、ヒータ44付きの熔融金属槽43を配置した真空チャンバー31と、これにシャッター35で開閉可能な開口部36で連通するバッファ用真空チャンバー37とを持ち、シリコン基板11を把持するワーク固定用アーム47を蓋50に取り付けている。両チャンバー31、37は、真空ポンプ装置34に吸引管33または真空粗引き用吸引管38を介して接続され、また、図示略の窒素ボンベに窒素導入管39、40を介して接続されている。

【0019】上記の金属充填装置30でシリコン基板11の貫通孔12に金属を充填する作業手順を説明すると、蓋50を閉じワーク固定用アーム47で把持したシ

リコン基板11をバッファ用真空チャンバー37内に位置させた状態で、バッファ用真空チャンバー37内部を真空ポンプ装置34により真空粗引きする。次いで、シャッター35を開く(なお、真空チャンバー31は先に減圧しておく)。次いで、真空ポンプ装置34で、真空チャンバー11およびバッファ用真空チャンバー17の内部を真空吸引し、真空圧 $10^{-2} \sim 10^{-8}$  Pa程度まで減圧する。次いで、ヒータ44で加熱して熔融金属槽43内の金属を熔融させ、熔融金属23内にシリコン基板11を挿入する。シリコン基板11が熔融金属23と同じ温度に達した後、真空チャンバー11およびバッファ用真空チャンバー17内に窒素ボンベからの窒素を導入して、内部を $2 \sim 5 \times 10^5$  Pa ( $2 \sim 5$  kgf/cm<sup>2</sup>)程度まで加圧する。この加圧により、熔融金属23が高アスペクト比の貫通孔12内に充填される。その後、シリコン基板11を熔融金属槽43から引き上げ、真空チャンバー31の外に取り出して、室温にて空冷する。これにより、シリコン基板11の貫通孔12への金属充填作業が終了する。

【0020】なお、貫通孔12の内壁面に絶縁層(酸化膜)を形成する方法としては、前述の熱酸化法に限らず、例えばSiO<sub>2</sub>系皮膜形成用塗布液等の液相により、低温条件下で形成することも考えられる。この方法は、既にシリコン基板11上に回路等が形成されている場合、それらに熱による影響を及ぼさないので、有利になる。

【0021】本発明は、シリコンICチップの積層高密度実装(3次元実装)に適用して好適である。図7は、シリコンICチップ(シリコン基板)の積層体を示す横断面図である。図中71は、光励起電解研磨法により2箇所の貫通電極72が形成されたシリコンICチップであり、該シリコンICチップ71は、ベース基板73上に、上下の位置を合わせて3枚積層されている。シリコンICチップ71は、例えば、同一ウエハから切り出された同一回路パターンを有し、ウエハ表面から見た場合において、各チップ内の同一位置に貫通電極72と回路パターン(図示せず)が形成され、これらの貫通電極72は、上下端を合わせて接続されている。すなわち、電極下端に設けられた半田パンプ74と、相手側チップ上の貫通電極上端が接続され、これらチップの貫通電極72は、シリコン製ベース基板73に形成された貫通電極72と位置合わせ接続される。この結果、ベース基板とシリコンICチップを貫通する共通電極が形成され、該共通電極の下端の半田ボール70は、図示しないベース基板の配線回路と接続される。ただし、敢えて貫通電極の上下位置を揃えないような設計をする場合には、一方のチップ下部の半田パンプを、他方のチップ上部の配線パターン(貫通電極と導通する他方のチップ上に形成された電極層)と接続する事も可能である。以上のように、高アスペクト比の貫通電極が形成された何枚かのICチップを任

意位置に位置決めして重ね合わせ接続することにより、複数層に積み上げられ実装密度の向上した3次元ICデバイスを作ることが可能である。なお、貫通電極の数は2本には限定されず、これは他の実施例においても同様である。

【0022】図8は、本発明の他の実施例であり、インターポーザを用いたICチップのチップサイズ実装を示す。図中81は、光励起電解研磨法により形成された2ヶ所の貫通電極82を有するシリコン製のインターポーザ(シリコン基板)あり、該インターポーザ上には、例えばフェースダウンされたICチップ83が搭載されている。ICチップ表面の電極84は、インターポーザ表面の導電層85を介して貫通電極82へ接続され、該インターポーザ下面においては、貫通電極82下端に形成された半田ボール86が、マザーボード(ベース基板)80上の配線パターンと接続されている。従来、インターポーザを用いたチップ実装では、マザーボードとの接続に制約が多く、配線密度にも限界があったが、本実施例では、高アスペクト比の貫通電極を複数形成することにより、インターポーザの配線パターン設計の制約が少なくなり、実装構造(あるいはパッケージ構造)を簡略化することができる。さらに、インターポーザの素材としてシリコンを用いているため、ICチップと熱膨張係数の整合性が良好になり、他のセラミック製のものに比較して、マザーボードへ実装する際にチップが受ける熱応力歪みが少なく、また、シリコンの熱伝達効率が比較的優れているため、チップの発生熱を逃がし易いという利点が得られる。さらに、一般に普及しているシリコン精密加工技術が使えるため表面配線パターンの精密化が可能という利点も得られる。

【0023】図9(A)は、本発明の他の実施例であり、貫通電極を有するイメージセンサを示す。図中、91はイメージセンサチップ90内の光電素子エリアであり、92は光励起電解研磨法によりシリコン基板93に形成された高アスペクト比の貫通電極である。該貫通電極92は、イメージセンサの能動領域(光電変換素子が形成された光電素子エリア)91の外側でチップ端部に形成され、その上端がチップ表面の電極層を介して能動領域91へ接続されている。また、下端は半田ボール94等を介して図示しないマザーボード表面の配線パターンと接続されている。

【0024】図9(B)は、ワイヤ接続方式のイメージセンサを示す。本図では、イメージセンサはチップの素子エリアと同一面に、該素子エリアに導通する比較的面積の大きなワイヤボンダッド95を形成し、ボンディングワイヤ96により外部のリードフレーム等と接続している。また、金線(ワイヤ)接続時に発生する熱等の影響を軽減するため、ワイヤボンダッドとイメージエリアは有る程度離隔する必要があり、以上の理由から、チップ表面に占めるイメージエリアの面積には制約があ

る。

【0025】これに対して、本発明では、高アスペクト比の貫通電極上端が、導電層97を介して光素子エリア91と接続されており、貫通電極下端の半田ボール94により外部と接続されるから、イメージエリアと同一面へのワイヤボンディングパッドが不要となる。従って、イメージセンサのチップ面積に占める素子エリアを大きくすることができるから、イメージセンサを小型化、あるいは限られた大きさのチップ内に広い面積の素子エリアを確保することができる。また、ワイヤボンディングが不要であるから、ベース基板への表面実装が容易となりイメージチップ実装基板の小型と薄型化、並びに製造コストの削減を計ることができる。

【0026】図10は、本発明の他の実施例であり、高アスペクト比の貫通電極が形成された光回路素子（光トランスマッタ）の横断面図を示す。図中100は、光励起電解研磨法により形成された4ヶ所の貫通電極101A、101B、101C（他の1ヶ所は図示せず）を有する精密加工されたシリコン製のブラットフォーム（シリコン基板）、101は、光ファイバ106を位置決め固定するV溝、102は面実装型LD（レーザダイオード）103の一方の電極面が接続される頂面が導電層102Aをなす断面台形状の突部、104はモニタ用PD（ホトダイオード）105の片側電極面に接続される凹底部が導電層104Aをなす逆台形状の凹部である。該突部102と該凹部104の下部には、導電層102A、導電層104Aと導通する貫通電極101Aと101Bが形成され、これら貫通電極101A、101Bの下端部は半田バンプ（パッド）を形成して、図示せぬ外部回路と接続される。一方、他の2ヶ所の貫通電極101C（1ヶ所は図示せず）は、ブラットフォーム表面100A上の2ヶ所の電極パッド110（1ヶ所は図示せず）に接続され、これら電極パッドから導出する2本のボンディングワイヤ（金線）109A、109BがLD103、PD105の他の片側電極面に接続される。更に具体的には、金線109AはLD103上の片側電極に直接ボンディングされ、金線109Bは素子電極に直接接続されるのではなく、ブラットフォーム上にメッキされた導電層104Aの延出部と接続される。ブラットフォーム100の下部では、これら貫通電極の下端が半田ボール111などを介して実装基板に表面実装される。

【0027】次に、これら光デバイスの並び方向は、光ファイバ106の軸心107と一致するように光軸が合わされており、LD103の射出光が光ファイバへ入射し、PD105がLD出力をモニタする。この実施例によれば、光素子下部の各導電層102A、104Aが貫通電極101A、101Bを介して外部回路と導通しているために、ブラットフォーム表面上の配線パターンの形成が簡略化される。また、ワイヤ（金線）ボンディングは、ブラットフォーム内の電極パッド110から光素子間だけ

であるから、光素子と外部リードフレームを接続するのに比較してワイヤ長が短くなり接続が容易となる。従って、光デバイス全体が小型化するのみならず、接続工数を経らすことができるため製品コストを低下させることができる利点がある。なお、上記ブラットフォームの形状を変更して、光ファイバからの外部入射光を受光用PDで受けるような構成とすれば、光レシーバを構成することができる。また、光ファイバを2本（V溝を2本）として、ブラットフォームを加工して同一ブラットフォーム上に、光トランスマッタと光レシーバを作り付ければ、光トランシーバが構成できる。

【0028】以上説明したように、本発明は、高アスペクト比の貫通電極を各種素子に形成することができ、また、汎用的なシリコン精密加工技術の利用が可能であるから、各種素子、デバイスの精密化、小型化、ならびに実装密度の向上を計ることができる。また、煩雑でコスト高となるワイヤボンディング等の工程を省略できるから、製品コストを低下させることも可能となる。なお、本発明はシリコン基板に貫通電極を形成する場合が主であるが、シリコン以外の素材による基板に貫通電極を形成することも考えられる。

【0029】

【発明の効果】本発明によれば、例えば光励起電解研磨法により基板に高アスペクト比の貫通孔を形成し、この貫通孔の内壁を酸化処理して絶縁層としての酸化膜を形成し、次いで、前記貫通孔に熔融金属埋め戻し法により金属を充填して、貫通電極を形成するので、高アスペクト比の貫通電極を容易に得ることができる。これにより、例えばシリコンICチップを積層した高密度実装の半導体パッケージや光デバイスを実現すること等が容易になる。

【0030】請求項2のように、貫通孔内壁に形成した酸化膜を一旦除去した後、再酸化して酸化膜を形成すれば、貫通孔内壁を平坦化することができ、良好な貫通電極を形成できる。

【0031】請求項3のように、貫通孔内壁に高濃度の不純物拡散を行って、酸化膜の外側に不純物拡散層を形成すれば、この不純物拡散層をシールド層として利用でき、ノイズの抑制に有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態の基板の貫通電極形成方法を工程に分けて説明する模式図であり、（イ）はシリコン基板にV形凹所を形成した段階、（ロ）は光励起電解研磨法で貫通孔をあけた段階、（ハ）は貫通孔内壁に酸化膜を形成した段階、（ニ）は貫通孔に金属を充填して貫通電極を形成した段階を示す。

【図2】本発明実施形態の貫通電極形成方法において、貫通孔の形成に用いる光励起電解研磨装置の模式図である。

【図3】上記の光励起電解研磨法で、V形凹所に選択的

なエッチングが行なわれる原理を説明する図である。

【図4】図1(ハ)の酸化膜の形成に際して、不純物拡散を行なってシールド層(不純物拡散)を形成した状態を示す模式図である。

【図5】本発明実施形態の貫通電極形成方法において、貫通孔への金属充填に用いる金属充填装置の要部の一部切り欠き正面図である。

【図6】上述の貫通電極形成方法で実際にシリコン基板に貫通電極を形成した実施例を示すもので、シリコン基板の貫通電極部分の断面の顕微鏡写真のスケッチである。

【図7】シリコンICチップ(シリコン基板)の積層体の横断面図である。

【図8】本発明の他の実施例を示すもので、インターポータを用いたICチップのチップサイズ実装を示す図である。

【図9】(A)は本発明のさらに他の実施例を示すもので、貫通電極を有するイメージセンサの断面図、(B)はワイヤ接続方式のイメージセンサを示す断面図である。

【図10】本発明のさらに他の実施例を示すもので、高アスペクト比の貫通電極が形成された光回路素子(光トランスマッタ)の横断面図である。

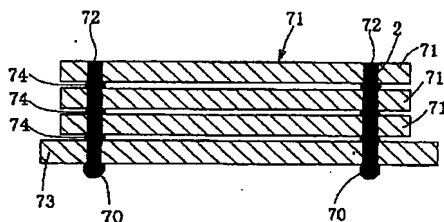
【図11】従来の異方性エッチング・半田の方法でシリコン基板に貫通電極の形成した場合における貫通電極部分の模式的な断面図である。

【符号の説明】

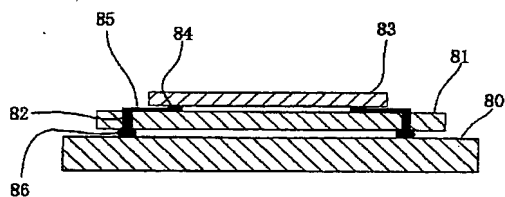
- 10 光励起電解研磨装置
- 11 シリコン基板
- 11a V形凹所
- 11b シリコン基板の表面
- 11c シリコン基板の裏面
- 12 貫通孔
- 13 電解液
- 14 光源
- 15 陰極電極
- 21 酸化膜
- 22 不純物拡散層(シールド層)
- 23 充填金属(熔融金属も同じ符号で示す)
- 30 金属充填装置

- \* 31 真空チャンバー
- 37 バッファ用真空チャンバー
- 34 真空吸引装置
- 43 熔融金属槽
- 44 ヒータ
- 70 半田ボール
- 71 シリコンICチップ
- 72 貫通電極
- 73 ベース基板
- 10 74 半田バンプ
- 80 マザーボード(ベース基板)
- 81 シリコン製のインターポータ(シリコン基板)
- 82 貫通電極
- 83 ICチップ
- 84 電極
- 85 導電層
- 86 半田ボール
- 90 イメージセンサチップ
- 91 光電素子エリア(イメージセンサの能動領域)
- 20 92 貫通電極
- 93 シリコン基板
- 94 半田ボール
- 97 導電層
- 100 シリコン製のプラットフォーム(シリコン基板)
- 101A、101B、101C 貫通電極
- 101 V溝
- 101A、101B 貫通電極
- 101C 貫通電極
- 30 102 突部
- 102A 導電層
- 103 面実装型LD(レーザーダイオード)
- 104 逆台形状の凹部
- 104A 導電層
- 105 PD(フォトダイオード)
- 106 光ファイバ
- 107 軸心
- 109A、109B ボンディングワイヤ(金線)
- 110 電極パッド
- \* 40 111 半田ボール

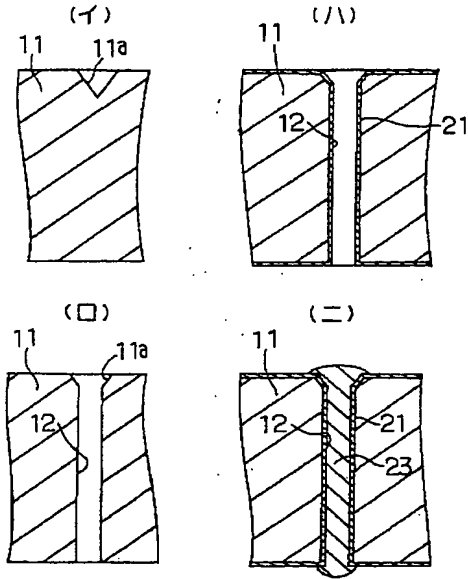
【図7】



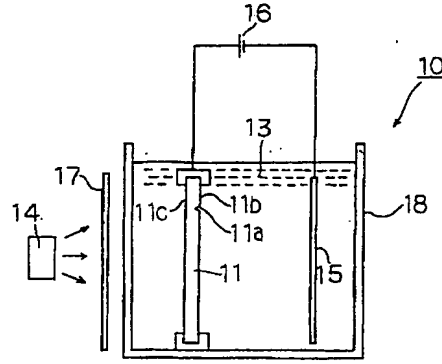
【図8】



【図1】

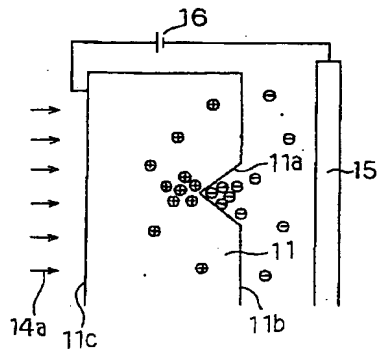


【図2】

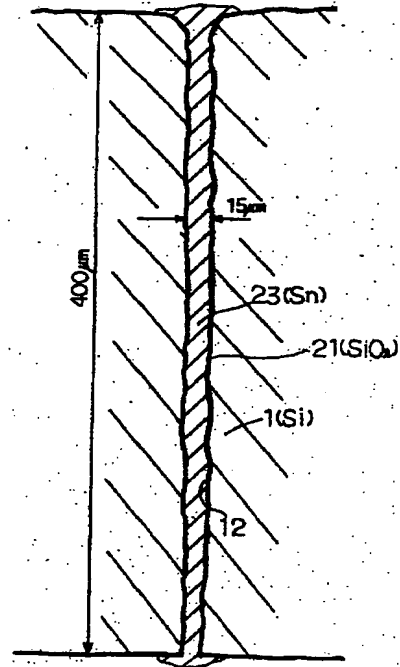
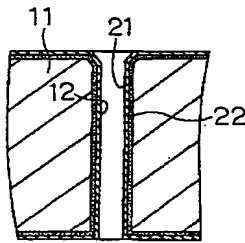


【図6】

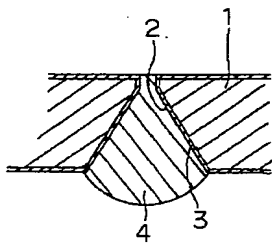
【図3】



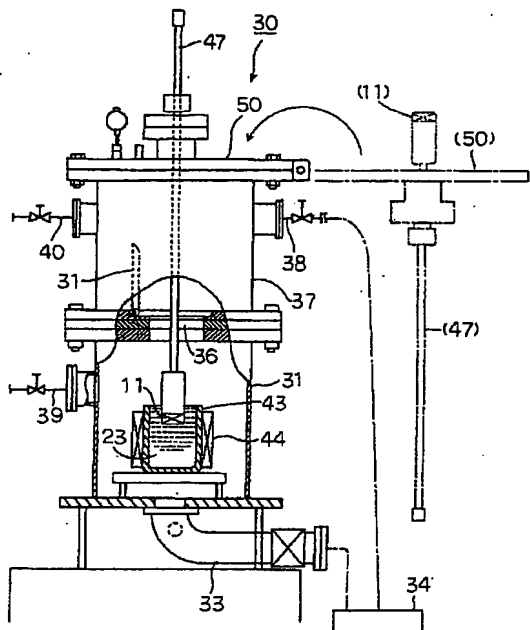
【図4】



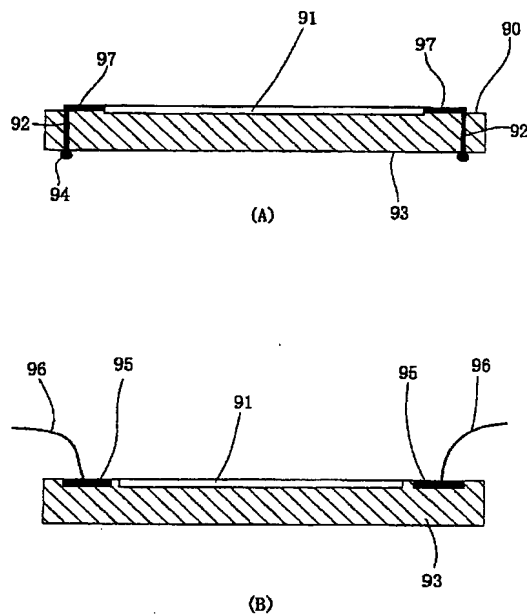
【図11】



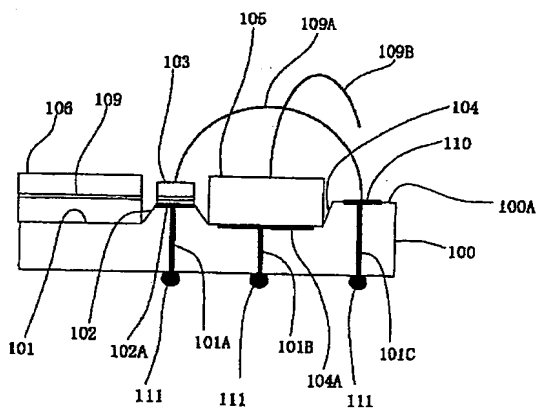
【図5】



【図9】



【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 末益 龍夫  
 東京都江東区木場1-5-1 株式会社フジクラ内

(72)発明者 糸井 和久  
 東京都江東区木場1-5-1 株式会社フジクラ内

Fターム(参考) 4M104 AA01 BB09 BB36 CC01 DD07  
DD09 DD22 DD23 DD26 DD31  
EE02 EE16 FF01 FF21 GG04  
GG05 HH14  
5F043 AA02 BB02 DD08 DD14 FF04  
FF06 GG04  
5F058 BC03 BE04 BE10 BF46 BF56  
BF63 BJ10

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**